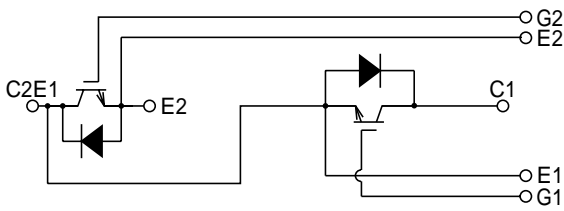


IGBT

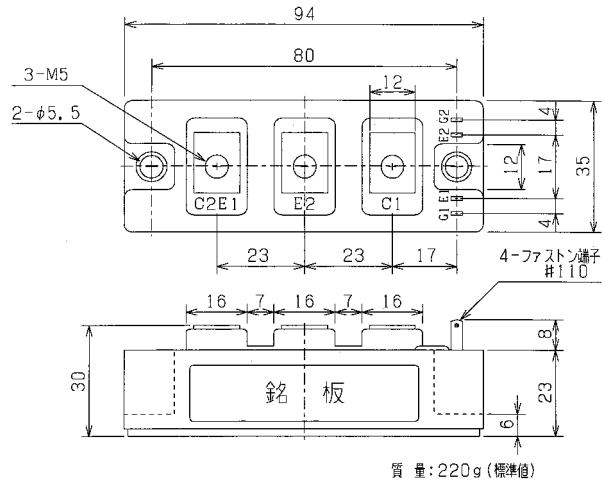
100 A 600 V

PDMB100A6

回路図 CIRCUIT



外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)



最大定格 Maximum Ratings (  $T_c = 25$  )

項目 Item	記号 Symbol	定格値 Rated Value	単位 Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	$V_{CES}$	600	V
ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	$V_{GES}$	$\pm 20$	V
コレクタ電流 Collector Current	DC	$I_c$	A
	1ms	$I_{CP}$	
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	$P_c$	400	W
接合温度 Junction Temperature Range	$T_j$	- 40 ~ + 150	
保存温度 Storage Temperature Range	$T_{stg}$	- 40 ~ + 125	
絶縁耐圧(端子 - ベース間, AC 1 分間) Isolation Voltage( Terminal to Base, AC 1 min.)	$V_{iso}$	2500	V <sub>(RMS)</sub>
締付トルク Mounting Torque	ベース取付部 Module Base to Heatsink	$F_{tor}$	N·m ( kgf·cm )
	端子部 Busbar to Terminal		
		2 ( 20.4 )	

電気的特性 Electrical Characteristics (  $T_c = 25$  )

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$	$V_{CE} = 600V, V_{GE} = 0V$			1.0	mA
ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	$I_{GES}$	$V_{GE} = \pm 20V, V_{CE} = 0V$			500	nA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_c = 100A, V_{GE} = 15V$		2.1	2.6	V
ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = 5V, I_c = 100mA$	4.0		8.0	V
入力容量 Input Capacitance	$C_{ies}$	$V_{CE} = 10V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$		10000		pF
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	$V_{CC} = 300V$ $R_L = 3$ $R_G = 7.5$ $V_{GE} = \pm 15V$		0.15	0.3	$\mu s$
	ターン・オン時間 Turn-On Time			0.25	0.4	
	下降時間 Fall Time			0.2	0.35	
	ターン・オフ時間 Turn-Off Time			0.45	0.7	

フリーホイールリングダイオードの特性 Free Wheeling Diode Ratings & Characteristics (  $T_c = 25$  )

項目 Item		記号 Symbol	定格値 Rated Value	単位 Unit
順電流 Forward Current	DC	$I_F$	100	A
	1ms	$I_{FM}$	200	

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
順電圧 Peak Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 100A, V_{GE} = 0V$		1.9	2.4	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F = 100A, V_{GE} = -10V$ $di/dt = 100A/\mu s$		0.15	0.25	$\mu s$

## 熱的特性 Thermal Characteristics

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
熱抵抗 Thermal Impedance	IGBT	接合部 - ケース間 Junction to Case			0.31	/W
	Diode				$R_{th(j-c)}$	

定格・特性曲線

Fig. 1 Output Characteristics (Typical)

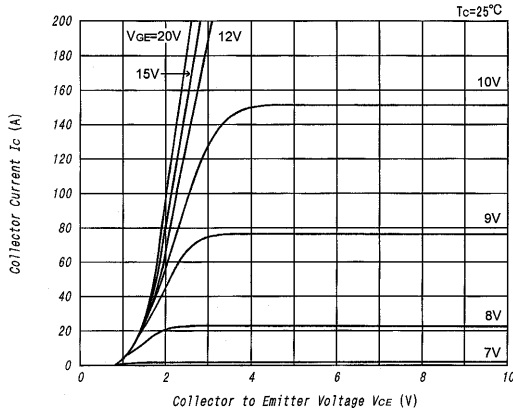


Fig. 2 Collector to Emitter on Voltage vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)

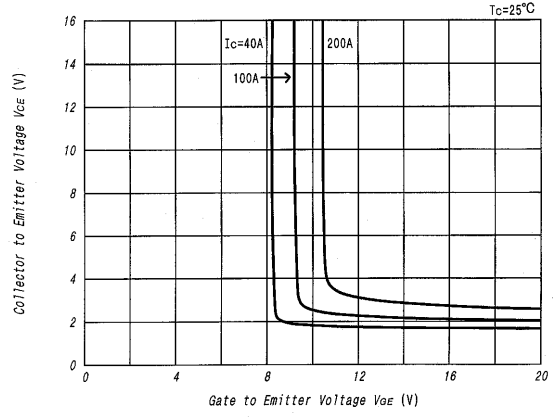


Fig. 3 Collector to Emitter on Voltage vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)

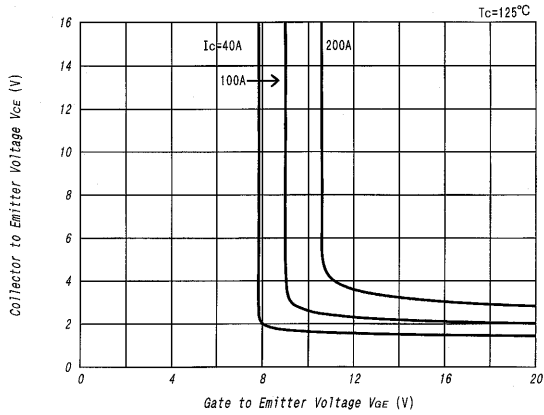


Fig. 4 Gate Charge vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)

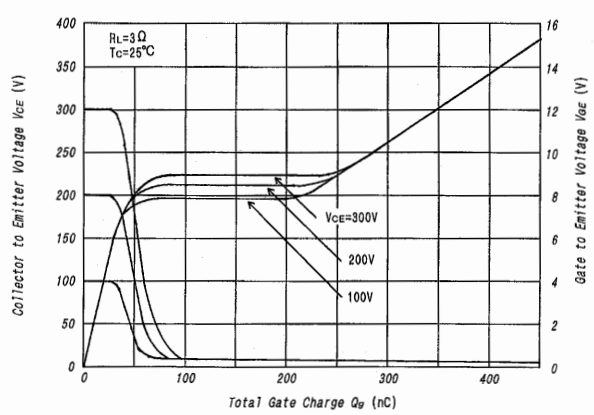


Fig. 5 Capacitance vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)

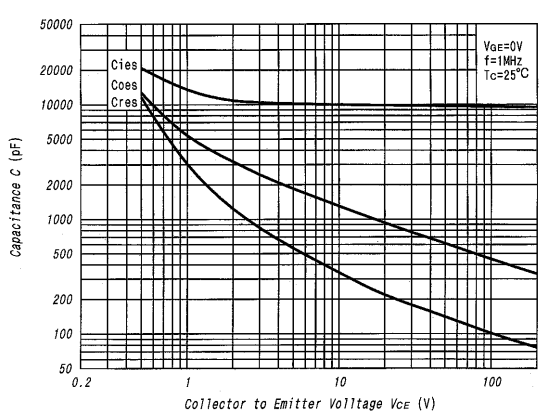


Fig. 6 Collector Current vs. Switching Time (Typical)

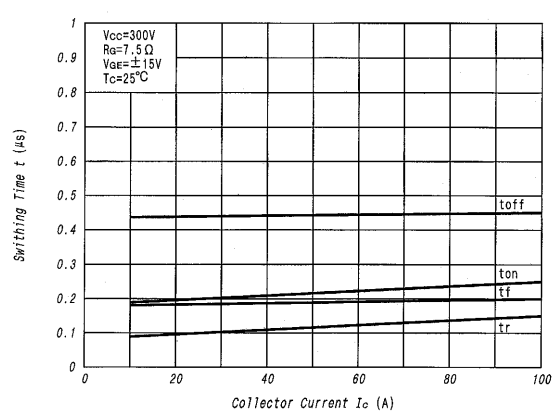


Fig. 7 Series Gate Impedance vs. Switching Time (Typical)

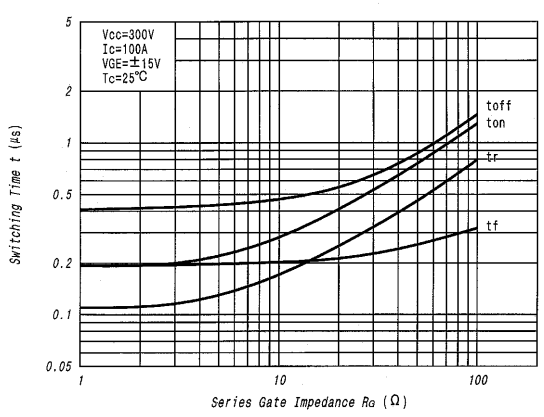


Fig. 8 Forward Characteristics of Free Wheeling Diode (Typical)

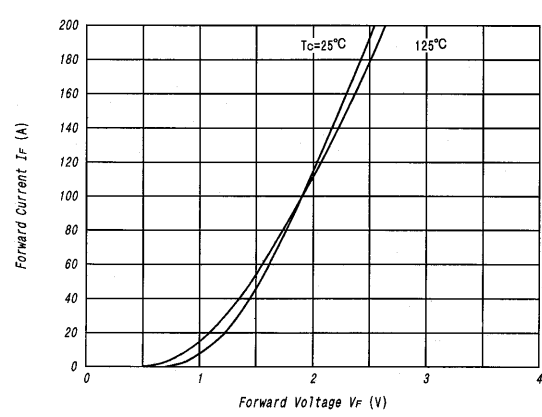


Fig. 9 Reverse Recovery Capacitance (Typical)

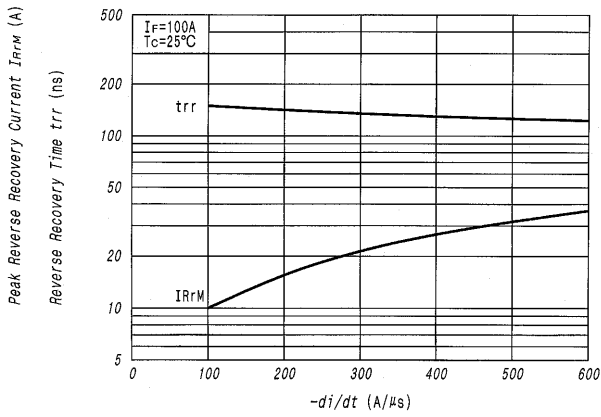


Fig. 10 Reverse Bias Safe Operating Area

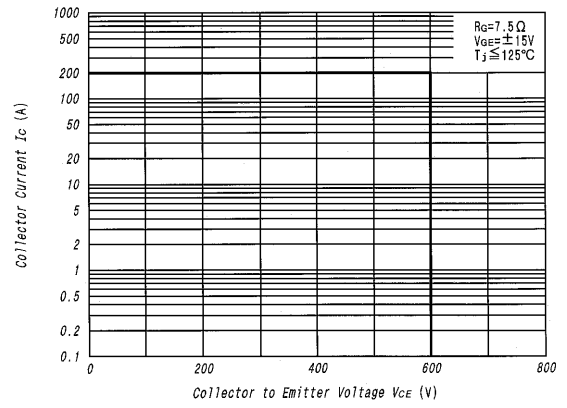


Fig. 11 Transient Thermal Impedance

